

Страница	Напечатано	Следует читать
538	В. П. Калинушкин, В. А. Юрьев «Изменение диаграммы рассеяния света монокристаллами нелегированного GaAs вследствие электронного облучения»	В. П. Калинушкин, В. А. Юрьев, Д. И. Мурин, Н. Г. Плоппа, Т. В. Тиме «Влияние процесса газофазной эпитаксии на скопления электрически активных дефектов в подложках из GaAs(Cr)»
540	В связи с этим можно допустить, что увеличение концентрации центра Ga _A s в скоплениях [4], вызванное термообработкой при 720 °С, несущественно, причем насколько можно судить атмосфера отжига не оказывает существенного влияния на скопления, расположенные в объеме подложки.	В связи с этим можно допустить, что увеличение концентрации центра Ga _A s в скоплениях [4] вызвано термообработкой при 720 °С, причем, насколько можно судить, атмосфера отжига не оказывает существенного влияния на скопления, расположенные в объеме подложки.